



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ

Номер регистрации (свидетельства):
2022660507

Дата регистрации: 06.06.2022

Номер и дата поступления заявки:
2022617824 28.04.2022

Дата публикации и номер бюллетеня:
06.06.2022 Бюл. № 6

Контактные реквизиты:
тел. +7 (499) 263-69-84 e-mail:
patent.bmstu@mail.ru

Автор(ы):

Андреев Дмитрий Владимирович (RU),
Андреев Владимир Викторович (RU),
Столяров Александр Алексеевич (RU)

Правообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский
университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) (RU)

Название программы для ЭВМ:

Программа измерения параметров подзатворного диэлектрика структур металл-диэлектрик-полупроводник при их тестировании методом возрастающего тока

Реферат:

Программа предназначена для управления автоматизированным комплексом по измерению параметров подзатворного диэлектрика структур металл-диэлектрик-полупроводник (МДП) при их тестировании методом возрастающего тока. Отличительной особенностью программы является возможность наряду с испытаниями, направленными на определение параметров времязависимого пробоя, проводить мониторинг изменения зарядового состояния подзатворного диэлектрика в течение всего процесса испытания. Для многих МДП приборов потеря их работоспособности возникает не в результате пробоя подзатворного диэлектрика, а существенно раньше в результате его зарядовой деградации, сопровождающейся недопустимым смещением порогового напряжения МДП транзистора и ухудшением его основных электрофизических характеристик. Следовательно, использование статистических измерений параметров, характеризующих зарядовую деградацию подзатворного диэлектрика наряду с параметрами времязависимого пробоя, может существенно повысить достоверность оценки надежности диэлектрической пленки и МДП-приборов на ее основе. Результатом работы программы является файл с массивом данных: плотность тока сильнополевой инжекции, напряжение на МДП-структуре в процессе стрессового воздействия, изменение напряжения при фиксированном инжекционном токе. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК; ОС: Windows/Linux.

Язык программирования: LabVIEW 2010 или выше

Объем программы для ЭВМ: 1,16 МБ